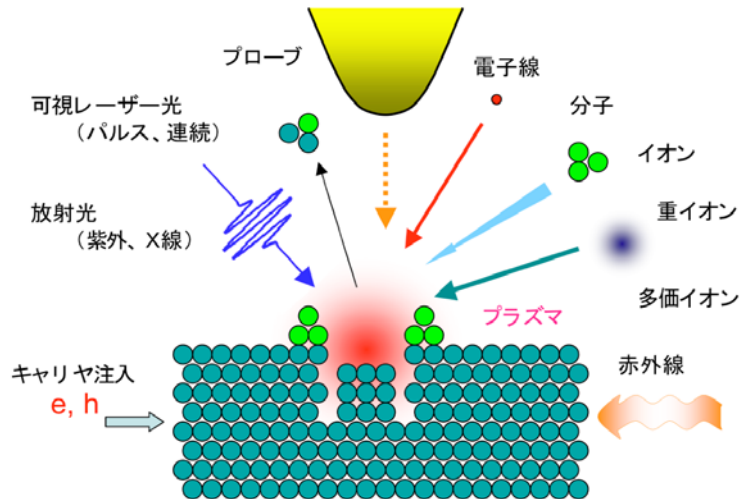


「励起ナノプロセスの基盤形成」 第1回研究会

日時：2006年 6月23日(金)～6月24日(土)

場所：金沢工業大学大学院 東京虎ノ門キャンパス 1102講義室

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル



プログラム

6月23日(金) 司会 前田康二(東大)、金崎順一(阪大)

13:30-13:40 はじめに

篠塚雄三(和歌山大)

13:40-14:25 量子ビーム利用による強非平衡系材料研究

渡辺精一(北大)

14:25-15:10 量子ビーム励起過程

松尾二郎(京大)

休憩

15:25-16:10 イオン・プラズマ誘起表面改質

目黒多加志(理研)

16:10-16:55 石英ガラスのレーザープラズマ軟X線アブレーション

村上浩一、牧村哲也(筑波大)

16:55-17:40 パルスX線とフェムト秒レーザーによる動的構造解析

腰原伸也(東工大)

6月24日(土) 司会 岩瀬彰宏(大阪府立大)、押山 淳(筑波大)

9:30-10:15 重イオン・レーザー複合照射

岸本直樹(物材機構)

10:15-11:00 パルスレーザー・電子線励起による物質ダイナミクス

北島正弘(物材機構)

休憩

11:15-12:00 赤外レーザー照射によるシリコン中の不純物酸素析出制御

金田 寛(富士通)

昼食

13:30-14:15 電子-格子相互作用による表面ナノ構造操作の理論

河合 伸(九大)

14:15-15:00 半導体成長表面の光学現象の理論

中山隆史(千葉大)